

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年9月29日(2005.9.29)

【公開番号】特開2003-157978(P2003-157978A)

【公開日】平成15年5月30日(2003.5.30)

【出願番号】特願2002-192850(P2002-192850)

【国際特許分類第7版】

H 05 B 33/14

C 07 D 311/30

C 07 D 311/60

C 07 D 407/04

C 07 D 409/04

C 07 D 455/04

C 09 K 11/06

// C 09 B 57/00

【F I】

H 05 B 33/14 B

C 07 D 311/30

C 07 D 311/60

C 07 D 407/04

C 07 D 409/04

C 07 D 455/04

C 09 K 11/06 6 3 5

C 09 B 57/00 N

C 09 B 57/00 P

C 09 B 57/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成17年5月12日(2005.5.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0133

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0133】

実施例19

図4に示す構造を有するITO堆積ガラス基板(開口絶縁膜ITO基板)を用い、図5に示す構造を有する有機電界発光素子を、以下の方法で作成した。

まず、図4において、ガラス基板上1にインジウム・スズ酸化物(ITO)透明導電膜をスパッタ法にて160nm堆積したものを、通常のフォトリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用いてパターニングして、陽極ITO2および陽極とは接していない位置に陰極取り出し部ITO8を形成した。ITOをパターン形成した基板には、通常のフォトレジストを用いて、陽極ITO2上に2mm×2mmの絶縁膜開口部9を有する開口絶縁膜10を設け、図4に示す構造を有する開口絶縁膜ITO基板11を作成した。次いで開口絶縁膜ITO基板11を超純水による水洗、界面活性剤を用いた超音波洗浄、超純水による超音波洗浄、超純水による水洗の順で洗浄後、窒素プローブで乾燥させた。最後に紫外線オゾン洗浄を行った。

次に下記に示す組成の溶液を調製し、洗浄済みの開口絶縁膜ITO基板11に、下記条件にてスピンドルコート、乾燥し、厚さ20nmの陽極バッファー層溶液塗膜を形成した。

## (陽極バッファー層溶液組成)

シクロヘキサン 10 ml  
高分子化合物1 130 mg  
電子受容性化合物1 13 mg  
スピナ回転数 1500 rpm  
スピナ回転時間 30秒

## (高分子化合物1)

下記繰り返し単位のみからなる、単独重合体であり、重量平均分子量は46700である。